

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載  
 【部門区分】第 7 部門第 2 区分  
 【発行日】平成 24 年 1 月 5 日 (2012.1.5)

【公表番号】特表 2011-507285 (P2011-507285A)  
 【公表日】平成 23 年 3 月 3 日 (2011.3.3)  
 【年通号数】公開・登録公報 2011-009  
 【出願番号】特願 2010-538326 (P2010-538326)  
 【国際特許分類】

H 0 1 L 33/64 (2010.01)

H 0 1 L 33/50 (2010.01)

H 0 1 L 33/60 (2010.01)

【F I】

H 0 1 L 33/00 4 5 0

H 0 1 L 33/00 4 1 0

H 0 1 L 33/00 4 3 2

【手続補正書】

【提出日】平成 23 年 11 月 8 日 (2011.11.8)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

少なくとも 1 つの金属体 ( 1 5 ) と積層体 ( 1 7 ) とを備えているオプトエレクトロニクス部品 ( 1 0 ) であって、前記積層体 ( 1 7 ) が、基体 ( 1 1 ) の上に貼り付けられており、電磁放射を放出するように具体化されており、少なくとも 1 つの側面領域に絶縁部 ( 1 2 ) が形成されており、

前記少なくとも 1 つの金属体 ( 1 5 ) が、前記絶縁部 ( 1 2 ) の少なくとも一領域に形成されており、自身が前記基体 ( 1 1 ) に熱伝導的に接触しているように具体化されている、

オプトエレクトロニクス部品 ( 1 0 ) 。

【請求項 2】

前記絶縁部 ( 1 2 ) が、絶縁層として、または絶縁積層体として具体化されている、請求項 1 に記載のオプトエレクトロニクス部品 ( 1 0 ) 。

【請求項 3】

前記絶縁層または前記絶縁積層体が、パッシベーション層もしくは少なくとも 1 つの空気層、またはその両方を有する、請求項 2 に記載のオプトエレクトロニクス部品 ( 1 0 ) 。

【請求項 4】

前記金属体 ( 1 5 ) が、前記積層体 ( 1 7 ) の少なくとも 3 つの側面領域を囲む、請求項 1 から請求項 3 のいずれかに記載のオプトエレクトロニクス部品 ( 1 0 ) 。

【請求項 5】

前記金属体 ( 1 5 ) が、前記積層体 ( 1 7 ) の 4 つの側面領域全てを囲む金属境界部として設計されている、請求項 1 から請求項 4 のいずれかに記載のオプトエレクトロニクス部品 ( 1 0 ) 。

【請求項 6】

前記少なくとも 1 つの金属体 ( 1 5 ) が 前記積層体 ( 1 7 ) のためのカットアウトを有

する金属マスク（４０）として具体化されている、請求項１から請求項５のいずれかに記載のオプトエレクトロニクス部品（１０）。

【請求項７】

前記金属体（１５）が、リング形状の構造を有する、請求項１から請求項６のいずれかに記載のオプトエレクトロニクス部品（１０）。

【請求項８】

前記基体（１１）が、セラミック体として、不動態化されたシリコンボディとして、または不動態化された金属体として、具体化されている、請求項１から請求項７のいずれかに記載のオプトエレクトロニクス部品（１０）。

【請求項９】

前記基体（１１）とは反対側の前記積層体（１７）の表面、の少なくとも一領域に、電流分散構造（１４）が形成されている、請求項１から請求項８のいずれかに記載のオプトエレクトロニクス部品（１０）。

【請求項１０】

前記少なくとも１つの金属体（１５）が、前記電流分散構造（１４）と、前記オプトエレクトロニクス部品（１０）との電気接続を形成する電気接続領域（１６）とに、導電接触している、請求項９に記載のオプトエレクトロニクス部品（１０）。

【請求項１１】

少なくとも１種類の蛍光体を備えている変換層（２０a）であって、前記基体（１１）とは反対側の前記積層体（１７）の表面、の少なくとも一領域上に形成されており、かつ、前記少なくとも１つの金属体（１５）に熱伝導的に接触している、前記変換層、を備えている、請求項１から請求項１０のいずれかに記載のオプトエレクトロニクス部品（１０）。

【請求項１２】

少なくとも１種類の蛍光体を備えている変換セラミック（２０b）であって、前記基体（１１）とは反対側の前記金属体（１５）の表面、の少なくとも一領域上に貼り付けられており、かつ、前記少なくとも１つの金属体（１５）に熱伝導的に接触している、前記変換セラミック、

を備えている、請求項１から請求項１１のいずれかに記載のオプトエレクトロニクス部品（１０）。

【請求項１３】

前記金属体（１５）が、前記変換セラミック（２０b）の支持キャリアとしての役割を果たす、請求項１２に記載のオプトエレクトロニクス部品（１０）。

【請求項１４】

前記少なくとも１つの金属体（１５）が、構成成分Au、Ag、Niのうちの少なくとも１つを備えている、請求項１から請求項１３のいずれかに記載のオプトエレクトロニクス部品（１０）。

【請求項１５】

前記少なくとも１つの金属体（１５）が、前記電磁放射を所定の放出方向に反射する反射器として具体化されている、請求項１から請求項１４のいずれかに記載のオプトエレクトロニクス部品（１０）。

【請求項１６】

前記少なくとも１つの金属体（１５）が電解法によって作製されている、請求項１から請求項１５のいずれかに記載のオプトエレクトロニクス部品（１０）。